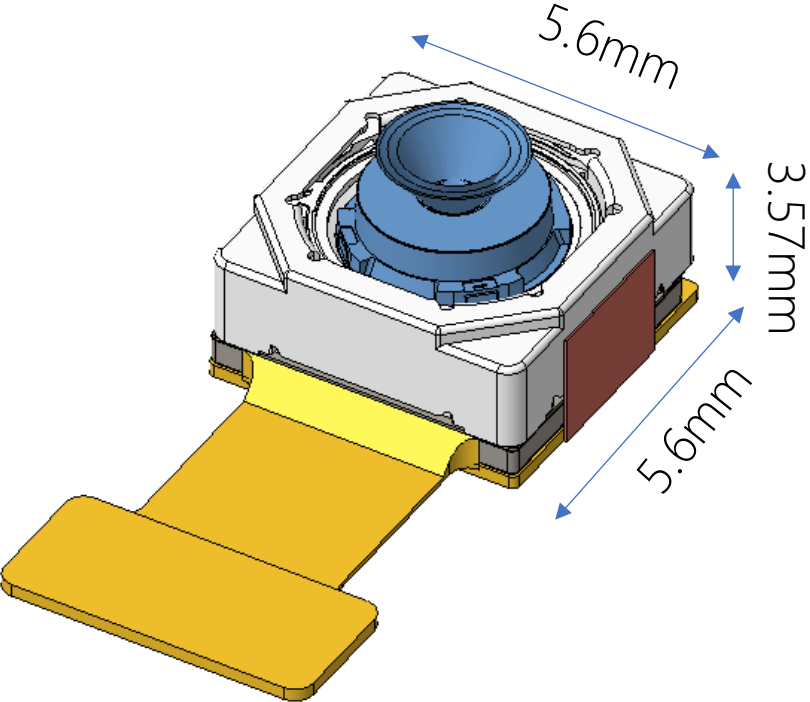


可见光芯片

可见光成像模块：手机平台



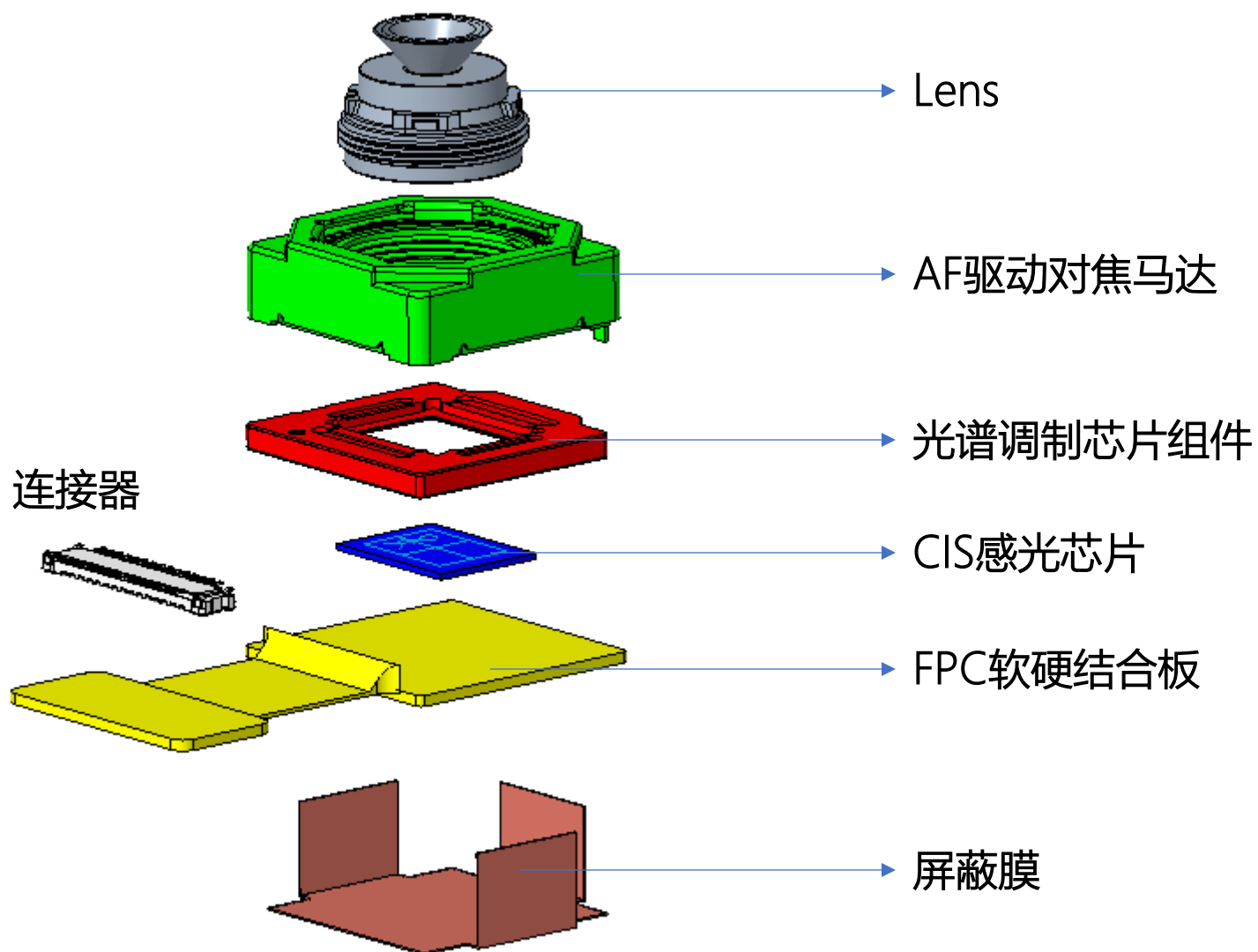
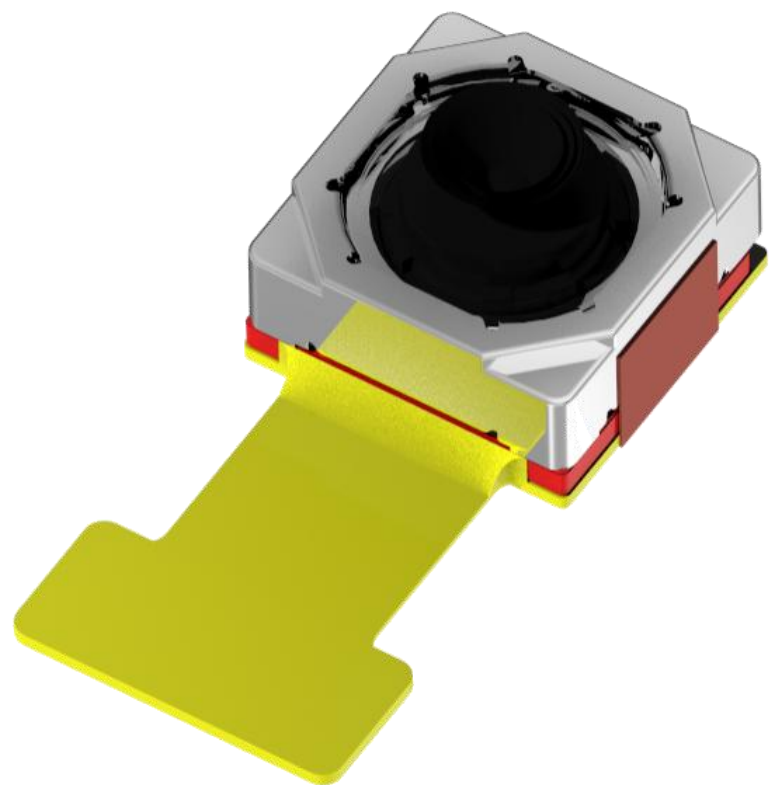
1.手机放一页

产品配置表

NO.	材料	参数
1	Lens	EFL: 2.85mm F#: 2.0 DFOV: 77° 畸变: <1% 镜头最大成像圆: $\varphi 4.8\text{mm}$ 相对照度: 30%
2	芯片	Size: 1/4" 8Mega COMS image sensor Pixel size: 1.12 μm Active pixel array: 3264X2448 Output formats: RAW 10bit 30fps: full size Shutter type: rolling shutter Interface: MIPI 2/4 lane
3	光谱调制 芯片	TBD
4	模组	类似: AF自动对焦模组 调焦距离: 7cm~inf. 整体尺寸: 8.62X8.5X4.44mm(本体尺寸不含FPC长度)

可见光芯片

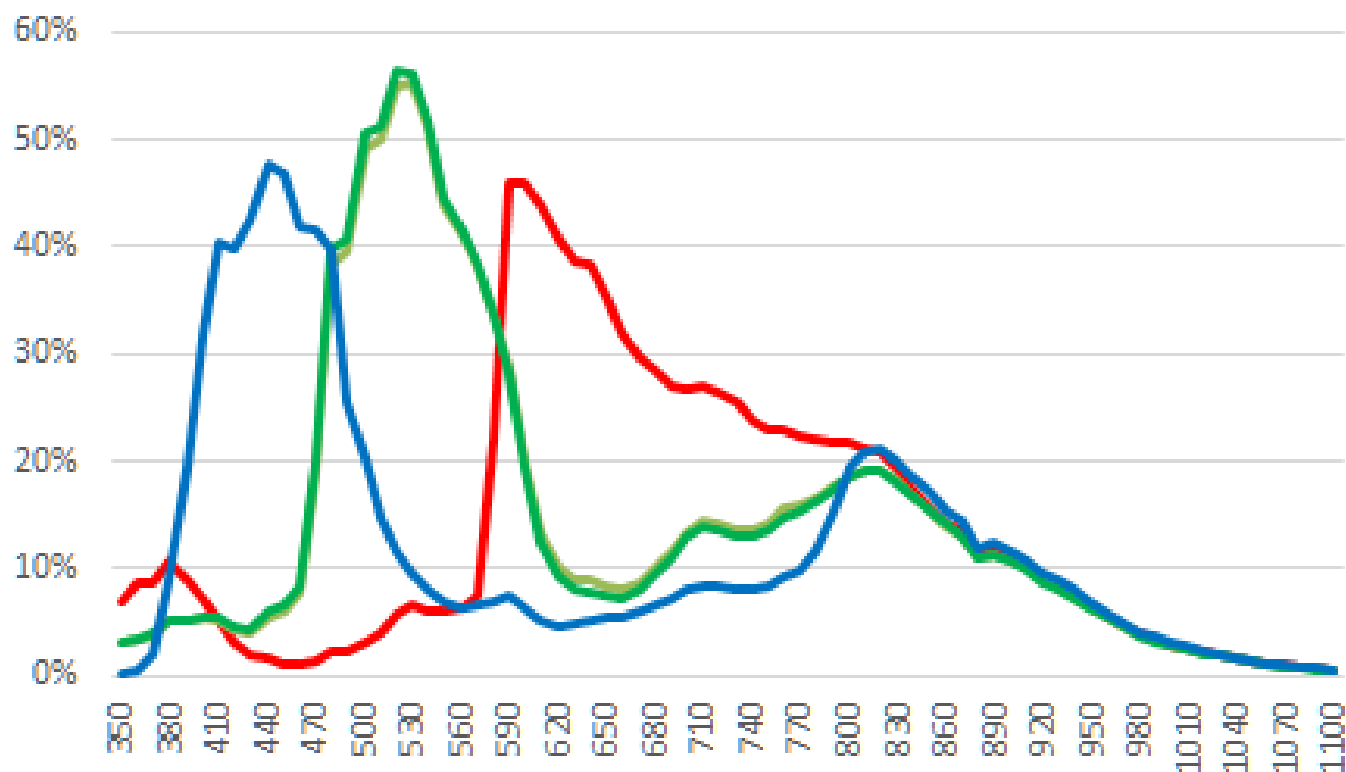
可见光成像模块：手机平台



可见光芯片

可见光成像模块：手机平台

芯片PD光谱响应曲线



模块光谱探测范围

成像谱段范围：0.4 μm -0.9 μm ;

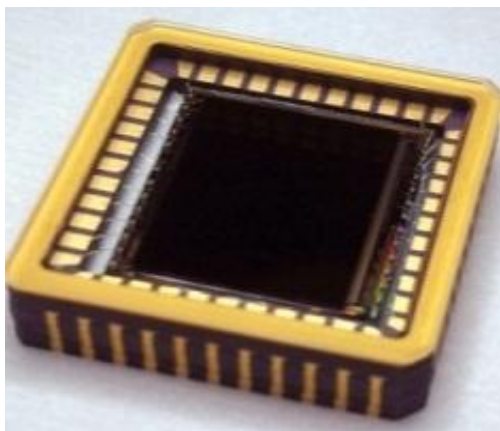
成像光谱谱段数：≥ 16个? ;

成像分辨率：3264X2448像素;

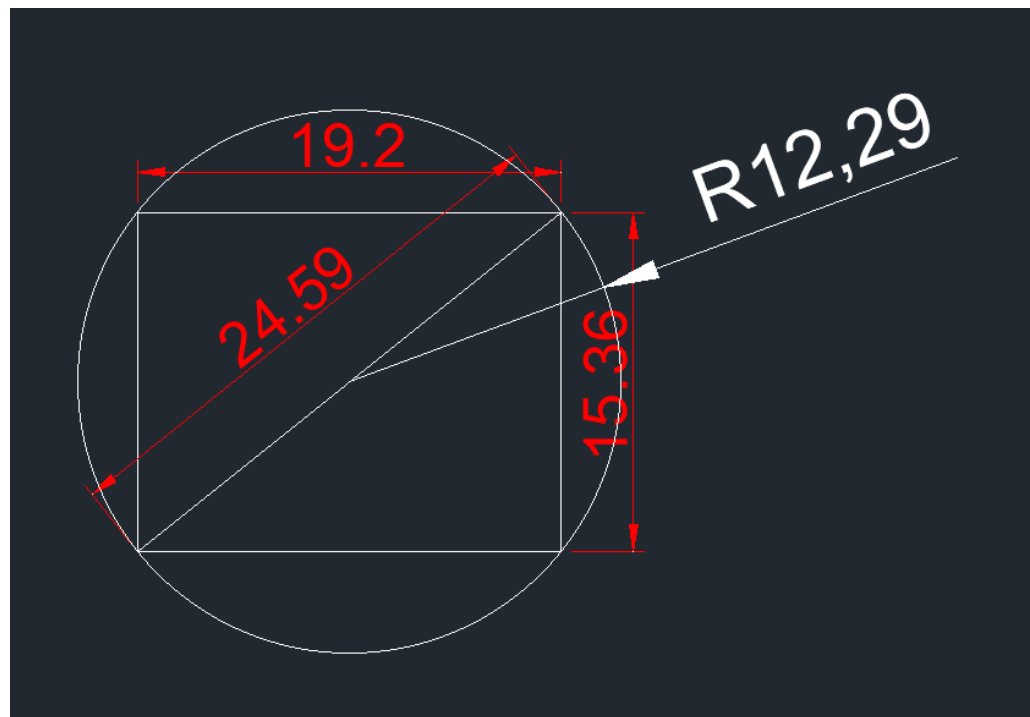
光谱成像分辨率：≥480×320

短波红外芯片

□ 短波红外芯片：44所

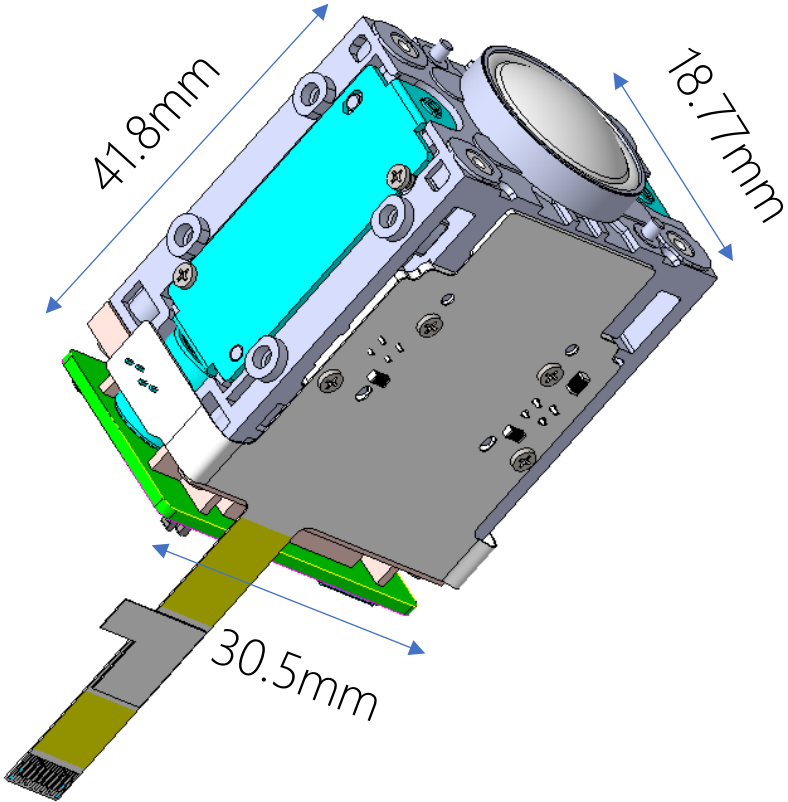


像元大小	15um
阵元规模	1280×1024
芯片尺寸	22.4×18.8mm
封装后尺寸	41×30×15mm



短波红外芯片

短波红外芯片：长焦

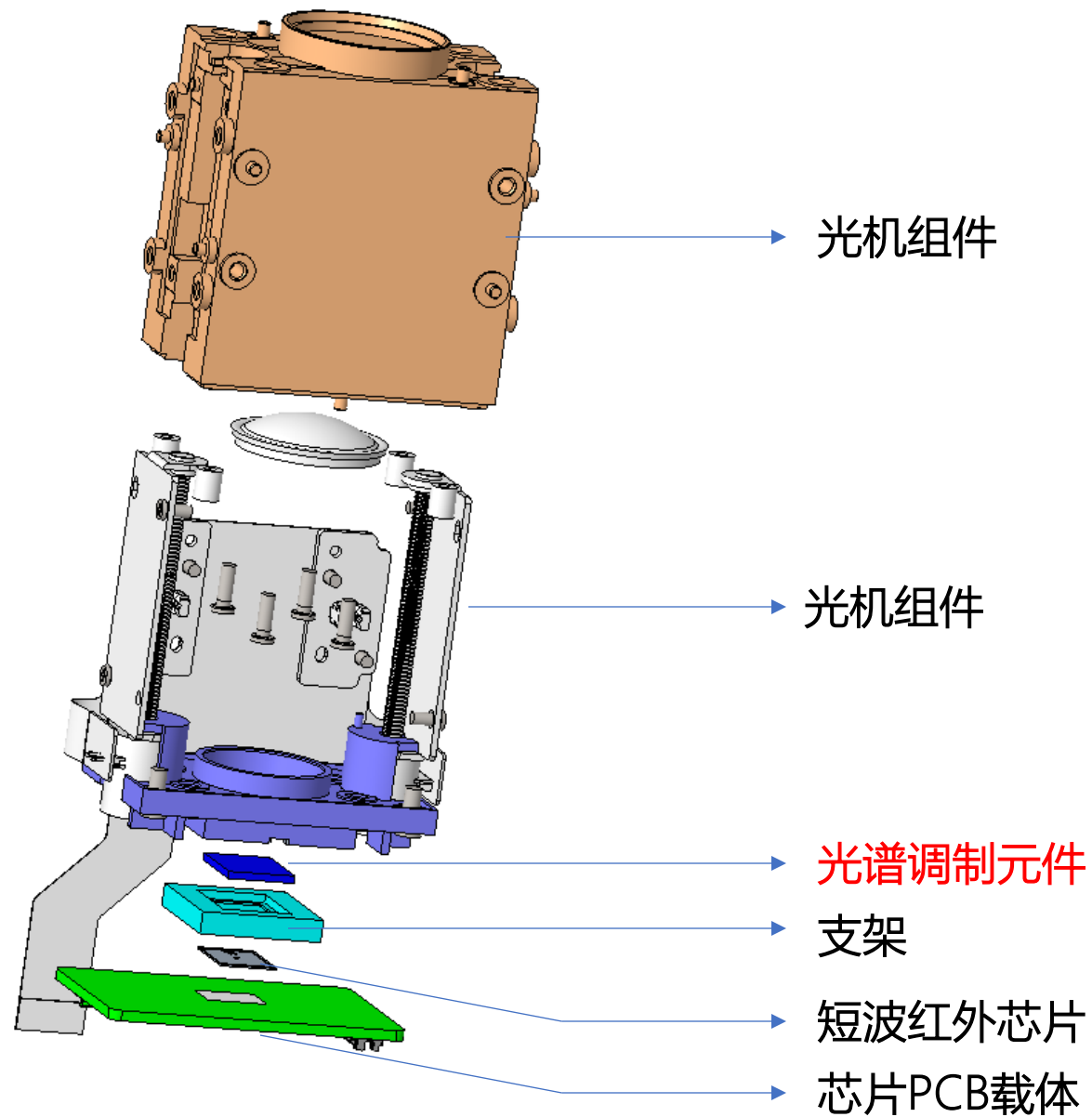
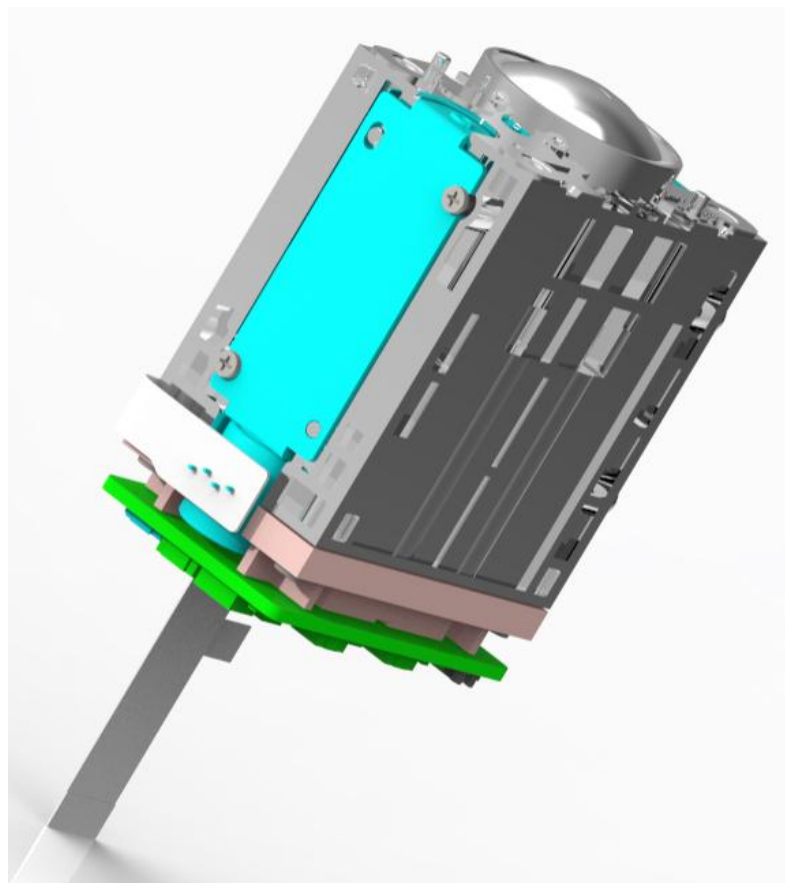


- 1.定焦镜头
- 2.

NO.	材料	参数										
1	Lens	EFL： WIDE 18mm/middle 29.2mm/TELE 46.3 F#： WIDE 3.7/middle 3.93/TELE 4.2 DFOV： <table><tr><td rowspan="3">F.O.V.</td><td>24.7 °(8mm)</td><td>15.34°(8mm)</td><td>9.7°(8mm)</td></tr><tr><td>20 °(6.4mm)</td><td>12.3°(6.4mm)</td><td>7.8°(6.4mm)</td></tr><tr><td>15.1°(4.8mm)</td><td>9.3°(4.8mm)</td><td>5.9°(4.8mm)</td></tr></table> 畸变： <1.6% 相对照度： >45% Lens construction： 8G2GMo	F.O.V.	24.7 °(8mm)	15.34°(8mm)	9.7°(8mm)	20 °(6.4mm)	12.3°(6.4mm)	7.8°(6.4mm)	15.1°(4.8mm)	9.3°(4.8mm)	5.9°(4.8mm)
F.O.V.	24.7 °(8mm)	15.34°(8mm)		9.7°(8mm)								
	20 °(6.4mm)	12.3°(6.4mm)		7.8°(6.4mm)								
	15.1°(4.8mm)	9.3°(4.8mm)	5.9°(4.8mm)									
2	短波红外芯片	Type： InGaAs短波红外焦平面探测器 Size： 光敏尺寸19.2x15.36mm Pixel size： 15x15um Active pixel array： 1280x1024 Shutter type： 全局快门 光谱范围： 0.95um~1.68um 其它： 内部集成温度传感器										
3	光谱调制芯片	TBD										
4	模组	类似： 10X光学变焦短波红外相机 整体尺寸： 41.8X30.5X18.77m										

短波红外芯片

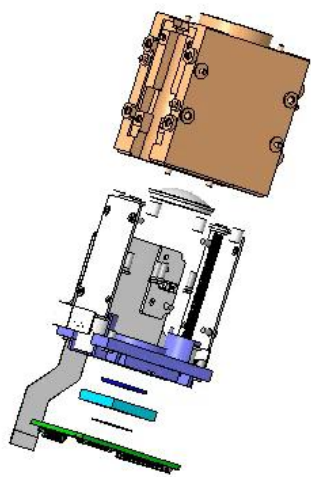
□ 短波红外芯片：长焦



短波红外芯片

□ 短波红外芯片：长焦

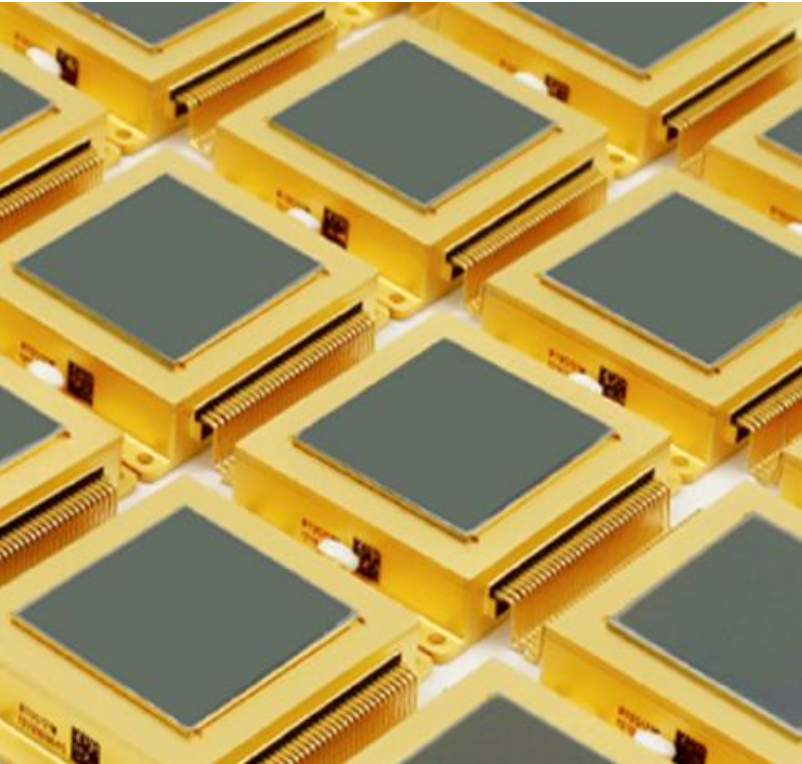
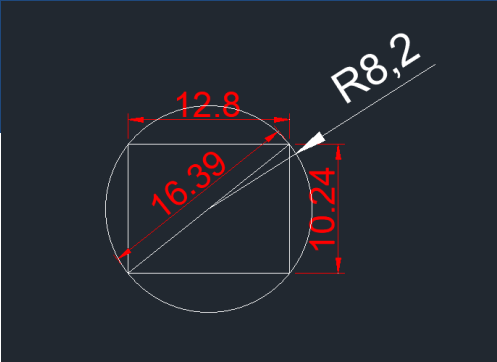
光机模块爆炸图演示动画



长波红外芯片

长波红外芯片：艾睿光电

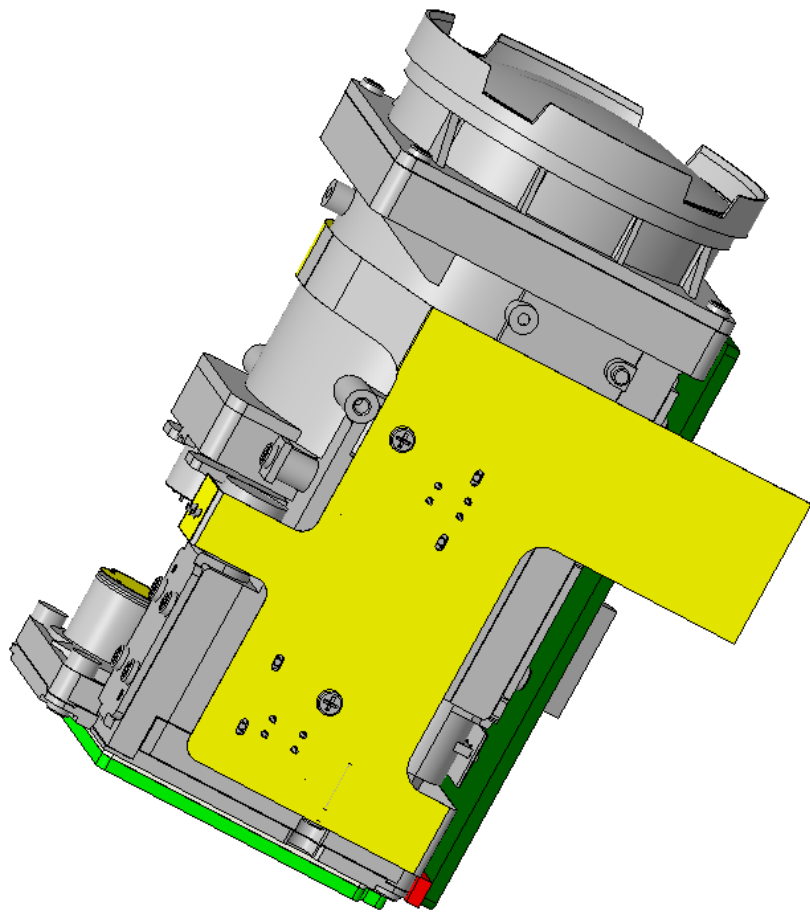
1280×1024



型号	RTDS101M
探测器类型	非制冷型氧化钒微测热辐射计
光谱响应谱段	LWIR , 8~14μm
像素中心距	10μm
阵列规模	1280 × 1024
可操作率	≥99.5%
NETD	≤50mK (@f/1.0 , 30Hz , 300K)
热响应时间	<10ms
帧频	≤60Hz
功耗	< 450mW(at 30Hz,300K,低功耗模式)
数字输出位数	14bits
工作温度范围	-40℃~+85℃
封装形式	金属真空封装
器件尺寸	41 × 31.5 × 8.31mm3(不计引脚尺寸)
封装重量	≤50g
读出模式	
镜像功能	
非均匀性校正功能	

长波红外芯片

□ 长波红外芯片：艾睿光电



NO.	材料	参数
1	Lens	EFL: 6.8 ($\pm 5\%$) ~120mm ($\pm 5\%$) F#: F1.61 ($\pm 5\%$) ~F4.13 ($\pm 5\%$) DFOV: D wide 65.3 D TELE4.2 畸变: < 0.4% wide 0.11 tele 相对照度: > 30% Lens construction: 5群14枚 5groups 14 elements
2	短波红外芯片	Type: 非制冷型氧化钒微测热辐射计 Size: 41x31x8.31mm ³ Pixel size: 10x10um Active pixel array: 1280x1024 光谱范围: LWIR 8-14um 热响应时间: 10ms 数字输出位数: 14bits
3	光谱调制芯片	TBD
4	模组	类似: 光学变焦长波红外相机 整体尺寸: 92X44.17X48.25m

长波红外芯片

□ 长波红外芯片：艾睿光电

